

# レーザー直接描画装置

製造:独 ハイデルベルグ・インストルメンツ

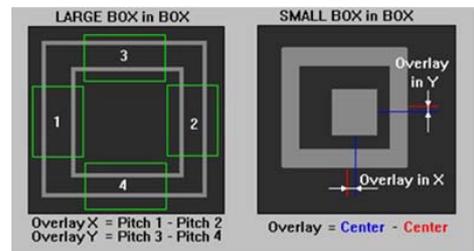
型番:DWL2000-OAF

設置場所:1階124室

## 機器外観・アライメント機構



外観



画像処理を利用した高精度  
アライメント機構(3 $\sigma$ 80nm)

## 機器の仕様

### 特長

- |                                     |                        |                         |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| ・ラスタ・スキャン方式による高速描画                  | ・最大描画エリア               | 200×200 mm <sup>2</sup> |
| ・高いアライメント精度                         | ・アドレス・グリッド             | 20 nm                   |
| ・高信頼性、長寿命な露光光源<br>(半導体レーザー、~4000時間) | ・最小描画サイズ               | 0.7 $\mu$ m             |
| ・エアゲージ/光学式オートフォーカス                  | ・描画スピード                | 110 mm <sup>2</sup> /分  |
|                                     | ・エッジラフネス(3 $\sigma$ )  | 70 nm                   |
|                                     | ・CD均一性(3 $\sigma$ )    | 80 nm                   |
|                                     | ・アライメント精度(3 $\sigma$ ) | 80 nm                   |

## 研究課題

- ・以下の課題を達成するための、中性子、X線、紫外、テラヘルツ検出素子、イメージングデバイス、無給電センサ用発電デバイス等の試作に使用
  - 課題1:波面制御光源による産業・医療分野のパラダイムシフトの実現
  - 課題2:赤外分光計測技術の革新と分子間相互作用の解明
  - 課題3:革新的時空間像構築(イメージング)技術の実用化
  - 課題4:光時空間遠隔制御(光リモート)技術の革新

問合先:静岡大・猪川 洋